



# 桂林斯壯微電子有限責任公司

## Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

GM6411

### SCHOTTKY DIODE 肖特基二極管

#### ■FEATURES 特點

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Power dissipation 耗散功率	$P_D(T_a=25^\circ\text{C})$	225	mW
Forward Current 正向電流	$I_F$	500	mA
Reverse Voltage 反向電壓	$V_R$	20	V
Junction and Storage Temperature 結溫和儲藏溫度	$T_J, T_{stg}$	125°C, -40to+150°C	

#### ■DEVICE MARKING 打標

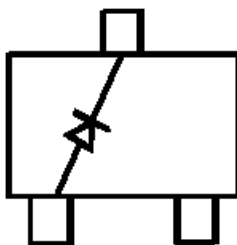
**GM6411=D2E**

#### ■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Reverse Breakdown Voltage 反向擊穿電壓 ( $I_R=600\mu\text{A}$ )	$V_{(BR)}$	20	—	V
Reverse Leakage Current 反向漏電流 ( $V_R=20\text{V}$ )	$I_R$	—	50	$\mu\text{A}$
Forward Voltage(Test Condition)正向電壓 $I_F=10\text{mA}_{dc}$ $I_F=50\text{mA}_{dc}$ $I_F=100\text{mA}_{dc}$ $I_F=500\text{mA}_{dc}$	$V_F$		230 280 320 480	mV
Diode Capacitance 二極體電容 ( $V_R=10\text{V}$ , $f=1\text{MHz}$ )	$C_D$	—	20	pF

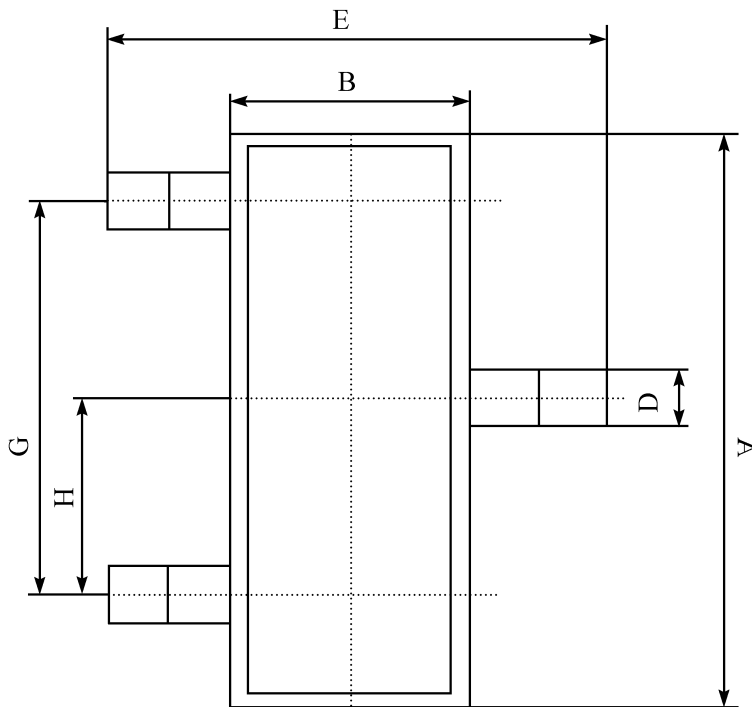
#### ■SOT-23 内部结构





GM6411

■DIMENSION 外形封裝尺寸



序號	數值及公差
A	2.90±0.10
B	1.30±0.10
C	1.00±0.10
D	0.40±0.10
E	2.40±0.20
G	1.90±0.10
H	0.95±0.05
J	0.13±0.05
K	0.00-0.10
M	≥0.2
N	0.60±0.10
P	7±2°

